# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-068157

(43)Date of publication of application: 03.03.2000

(51)Int.CI.

H01G 9/04

H01G 4/10

H01G 9/012

(21)Application number: 10-240541

(71)Applicant: SHOWA DENKO KK

(22)Date of filing:

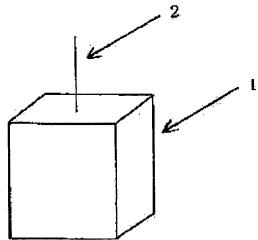
26.08.1998

(72)Inventor: NAITO KAZUMI

## (54) CAPACITOR

# (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve the LC(leakage current) characteristic of a capacitor, by employing a niobium metal as its one electrode and a tantalum metal as its drawn-out lead to the external. SOLUTION: The shape of a niobium metal used as one electrode 1 of a capacitor is employed from among a plate, foil, rod, sintered body, and the like. Its size is determined arbitrarily, considering the capacity of the created capacitor. Also, the shape of the tantalum metal used as a drawn-out lead 2 is selected as one of a plate, foil, and rod to employ its smaller size than the electrode 1 of the niobium metal. The lead 2 is connected electrically with the electrode 1, using a weld or conductive paste. Also, making the niobium metal sued as the one electrode 1 of the capacitor a niobium nitride nitrized partially, the LC(leakage current) characteristic of the capacitor is further improved. The niobium nitride is obtained to nitrize a portion of the niobium metal in a nitrogen atmosphere. Also, a niobium oxide is used as the dielectric of the capacitor.



# **LEGAL STATUS**

Date of request for examination

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出職公開發号

特開2000-68157

(P2000-68157A)

(43)公園日 平成12年3月3日(2000.9.3)

(51) Int-CL?		識別配号	FI			ラーマコード(参考)
H01G	9/04		H01G	9/05	H	5E082
	4/10			4/10		
	9/012			9/05	P	

## 審査部水 未請水 語水項の数3 OL (全 6 円)

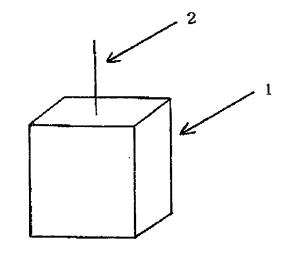
(21)出職番号	特膜平10-240541	(71) 出廢人 000002004
(22)出顧日	平成10年8月26日(1998.8.26)	昭称電工株式会社 東京都港区芝大門1丁目13番9号
		(72) 発明者 内藤 一美 千葉県千葉市緑区大野台1丁目1番1号 昭和電工株式会社総合研究所内
		(74)代理人 100094237 弁理士 矢口 平
		アターム(参考) 5E082 AB09 BC14 BC39 EE03 EE23 FG03 FG27 FG44 GG04

# (54) 【発明の名称】 コンデンサ

# (57)【要約】

【課題】 単位重置あたりの容置が大きく、漏れ電流特性の良好なコンデンサを提供する。

【解決手段】 コンデンサの一方の電極をニオブ又は一部室化された窒化ニオブとし、該電極に電気的に付着した外部引出しリードをタンタルとする。



10

特別2000-68157

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 二つの電極と、電極間に介在する誘電体 とから構成されたコンデンサにおいて、電極の一方がエ オブであり、該電極に電気的に付着した外部引出しリー ドがタンタルであるコンデンサ。

1

【請求項2】 電極の一方としてのニオブが、一部窒化 された窒化ニオブであることを特徴とする請求項1に記 鉞のコンデンサ。

【請求項3】 誘弯体が酸化ニオブであることを特徴と する語求項1又は請求項2に記載のコンデンサ。

# 【発明の詳細な説明】

### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、新規なコンデンサ とりわけ単位重量あたりの容置が大きく、漏れ電流(以 下しCと略す)特性の良好なコンデンサに関する。

#### [0002]

【従来の技術】近年の電子機器は、軽薄短小であること が専ばれているが、内部に使用される電子部品も、同様 に小型化することを要求されている。特にコンデンサに おいては、小型大容量のものが望まれている。

【0003】とのようなコンデンサの中でも電極にタン タル金属を使用したタンタルコンデンサは、大きさの割 には容置が大きく、しかも性能が良好なため貴重な存在 である。

#### [0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、 タンタ ルコンデンがは、さらに容量を大きくするには、内部の タンタル金属の表面補を大きくする必要があるが、タン タル金属の形状にタンタル紛の焼結体を用いたとして も、タンタル紛の微細化が要求され、この場合発火とい 30 う危険性が伴うため限界があった。

【①①05】このような欠点を克服するために、ニオブ 金属を電極にしたニオブコンデンサが考えられている が、LC特性が不良で実際には実用に耐えない。

#### [0006]

【課題を解決するための手段】一般にニオブコンデンサ は、電極としてのニオブから外部に容量引出し用の引出 しリードが電気的に接続されているが、通常、その引出 しリードの材質は、電極と同種金属のニオブである。本 発明者は、前記したLC特性の不良の一つが、該引出し リードと電極との接続点で発生することを見出し 本発 明を完成させるに至った。

【①①07】本発明は、電極の一方をニオブとし、外部 引出しリードをタンタルとしたコンデンサ、さらには、 電極の一方を一部窒化された窒化ニオブとし、外部引出 しリードをタンタルとしたコンデンサである。このコン デンサは単位重量あたりの容置が大きく、LC特性が良 ためもす まむ ドベットがいるの話を仕しては話を命

[8000]

【発明の実施の形態】本発明に使用する電極の一方とし てのニオブの形状は、板、器、棒、焼結体等である。大 きさは作製するコンデンサの容量を勘案して任意に決定 される。箔、簪の場合は、折り曲げたり、巻回して、単 位体積あたりの表面積を増大させて使用してもよい。ニ オブの焼結体は、例えば、ニオブ粉を加圧成型した後1 0°~10°Torr下で500~2000℃. 數分~ 数時間放置することによって得られる。

【0009】また、本発明で引出しリードとして使用さ れるタンタルの形状は、飯、箱、棒であり、大きさは一 般に前記した電極であるニオブより小さくして用いられ る。電極との接続は、溶接や導電ペーストによって電気 的に接続されるが、電極の形状が焼結体の場合。例え は、ニオブ粉末を加圧成型する時にタンタルリードを挿 入しておき、同時に焼箱して焼箱体と電気的接続を取っ てもよい。また、引出しリードの個數は1個以上であっ てもよい。

【0010】コンデンサ形成後、エージング操作を行っ 20 てし〇値を下げることができるが、前記した電極とリー ドとの接続部には内部応力が常に存在するため。 急なし C不良を突発させる原因となる。

【0011】しかるに本発明のように、ニオブ電極にタ ンタルリードを接続した場合、ニオブリードの場合と比 較してLC不良をおこす可能性が小さい。この理由は定 かではないが、後述するように、タンタルリード上に形 成される誘電体の方が、ニオブリード上に形成される誘 電体よりも安定であり、LC発生が少ないものと想像で

【0012】また、穹極の一方としてのニオブを、一部 窒化された窒化ニオブとすることにより、LC特性がさ ろに良好になり、該窒化ニオブは、低しCを要求される 回路用のコンデンサの電極とすることができる。本発明 の窒化ニオブとは、金属ニオブの一部を窒素化したもの であるが、例えばニオブを窒素雰囲気下で表面を窒素化 することによって得られる。この場合、窒素量は敷10 ~20万重量ppmになる。好ましくは数100~数万 重量ppmである。

【0013】窒素化する温度は2000℃以下で、時間 40 は数10時間で目的とする窒素量の窒化ニオブが得られ るが、一般に高温程、短時間で表面が窒素化される。ま た、室温でも、窒素下に数10時間ニオブ金属を放置し ておくと数10重量 p p mの窒素量の窒化ニオブが得ら

【①①14】前記コンデンサの誘電体として、例えば酸 化タンタル、酸化ニオブ、ポリパラキシレン等の高分子 物質、チタン酸バリウム等のセラミックス化合物を使用

3/29/2004

毎関2000-68157

コキシ錯体、アセチルアセトナート語体等を電極に付着 後、水分解および/又は熱分解することによって作製す ることもできる。

【①①16】酸化ニオブを誘電体として用いる場合、酸化ニオブは、一方の電極であるニオブ又は一部窒化された窒化ニオブを電解液中で化成するか。又はニオブを含有する錯体、例えばアルコキシ錯体、アセチルアセトナート結体等を電極に付着後、水分解および/又は熱分解するかして作製することもできる。電解液中で化成して得る場合、本発明のコンデンサは、電解コンデンサとなり、ニオブ又は窒化ニオブ側が陽極となる。錯体を分解して得る場合、ニオブ又は窒化ニオブは、理論的に極性はなく、陽極としても陰極としても使用可能である。

【①①17】また、高分子物質、セラミックス化合物を 誘電体とするには、特公平7-63045号公報、特公 平7-85461号公報の方法が利用できる。

【①①18】とれるの護電体のうち、酸化ニオブは、とりわけ誘電率が大きく、また誘電率の温度依存性が小さいためこの誘電体を使用したコンデンサは、容量が大きく、また性能の良好なコンデンサとなりうる。

【①①19】本発明において、電極に電気的に付着した外部引出しリードがタンタルであると、この引出しリードがニオブの場合に比較して、作製したコンデンサのL C不良が少ない。この理由の一つとして、前述した誘電体は、電極に接続したリード上の一部にも形成されるが、タンタルは、ニオブに比較して酸素との反応性が殺分低いため、該誘電体自身から酸素を引き抜いたり、空気と反応した酸素が誘電体を劣化させたりする可能性が低いためと想像できる。

【①①20】また、前述したように、タンタルリードを使用した窒化ニオブを電極に利用すると、ニオブ電極を使用した場合に比較して、作製したコンデンサのしC値はさらに良好になるが、この理由の一つとして、ニオブの酸素反応性を、ニオブの一部を窒化することによって緩和していて、誘電体の安定性を増大させているものと考えられる。

【① ① 2 1 】一方、本発明のコンデンサの他方の電極として、アルミ電解コンデンサ業界で公知である電解液、有機半導体あよび無機半導体から選ばれた少なくとも一種の化台物が挙げられる。このような化台物の例として、例えば、ベンソピロリン4 登体とクロラニルからなる有機半導体、テトラチオテトラセンを主成分とする有機半導体、下記式(1)又は(2)で表わされる高分子にドーバントをドープした電響性高分子を主成分とする有機半導体、二酸化鉛又は二酸化マンガンを主成分とする無機半導体、四三酸化鉄からなる無機半導体等が挙げる無機半導体、四三酸化鉄からなる無機半導体等が挙げ

$$\begin{array}{c|c}
R^* & X \\
\downarrow & \downarrow \\
R^* & R^*
\end{array}$$

(R<sup>1</sup> 乃至R<sup>2</sup> は水素、アルキル基又はアルコキシ基、 Xは酸素、イオウ又は窒素原子、R<sup>2</sup> はXが窒素原子の 時のみ存在して水素又はアルキル基、R<sup>2</sup> 、R<sup>2</sup> および 16 R<sup>2</sup> 、R<sup>2</sup> は互いに結合して環状になっていてもよ し、)

[0023]

【化2】

$$\begin{array}{c|c}
R' & R'' \\
\hline
 & X \\
\hline
 & R'' \\
 & R'' \\
\hline
 & R'' \\
\hline
 & R'' \\
 & R'' \\
\hline
 & R'' \\
 & R''$$

20 (R<sup>1</sup>, R<sup>1</sup> は水素、アルキル基又はアルコキシ基、X は酸素、イオウ又は窒素原子、R<sup>1</sup> はXが窒素原子の時 のみ存在して、水素又はアルキル基、R<sup>1</sup>, R<sup>1</sup>は互い に結合して環状になっていてもよい。)

【0024】式(1) 又は式(2) で表わされる高分子の例として、例えばポリアニリン、ポリオキシフェニレン、ポリフェニレンサルファイド、ポリチオフェン、ポリフラン、ポリビロール、ポリメチルビロール等が挙げられる。

[0025]

【実施例】以下、本発明を実施例によりさらに詳細に説明する。

実施例1~7

幅5 mm、長さ200 mm、厚さ100 μ mのニオブ箱 の中心に、太さり、3 mm o、長さ10 mmのタンタル 線の一部分(長さ2mm分)を溶接した後巻回して、タ ンタルリード線が付着した電極を形成した。一方、別に 用意したペンタエチルニオベート液中に該電極のタンタ ルリードの上から7mmを残して浸漬し引上げた後、8 5℃蒸気中で反応させ、さらに500℃で乾燥すること 40 により電極上に酸化ニオブの誘電体層を形成した。さら に、誘電体上に表して示される他方の電極を形成し、カ ーポンペースト、銀ペーストを順次浸漬、乾燥すること によって積層した。一方、別に用意した前述のタンタル **褪と同形状のタンタル線を乾燥した銀ペースト上に付着** させ、外部引出しリードが2本(ニオブ電極に1本、銀 ペースト上に1本)付着した素子を得た。引き続きエポ キシ樹脂で封口してコンデンサを作製した。 表2に作製 ざいみの余典しり とりゃかしり はもこしゃ

特闘2000-68157

タエチルタンタレートを使用して、誘電体に酸化タンタ ルの誘電体を形成した以外は、実施例1と同様にしてコ ンデンサを作製した。

## 【0027】実施例9

拉径10~40μmのニオブ粉末を400℃の窒素雰囲 気中で反応させ、窒化ニオブ粉末とした。窒素量約20 () () 重量ppmであった。該粉末約()、1gとタンタル リード(). 3mma、長さ15mmを同一に成型して、 大きさ3×3×0.2mmの成型体(タンタルリード観 が2mm成型体に入っていて、外部に13mm突き出て いる)を得た。ついで該成型体を真空中1500°Cで焼 結させ窒化ニオブ焼結体を得た。ついでりん酸水溶液中 で20V化成することにより焼結体上に酸化ニオブの誘 電体を形成した。さらに該誘電体上に実施例4と同様 な、もう一方の電極を形成した。引き続き、他方の電極 上に実施例1と同様にして、カーボンベースト、銀ベー ストを綺層し、ついでリードを引出してエボキシ封口し てコンデンサを作製した。

## 【0028】実施例10

実施例9で誘電体層まで形成した後、インプチルトリプ×2G

\*ロビルアンモニウムテトラボロフルオライド電解質を5 %溶解したジメチルホルムアミドとエチレングリコール の混合溶液からなる電解液を焼結体に付着させた。さら に、窒化ニオブ電極に付着したタンタルリードの上部3 mmが外に出るように円筒状のゴムに通した後。コンデ ンサ素子部を缶に入れ、缶の上部でゴムをかしめ付け し、封口した。

## 【0029】比較例1~10

実施例1~10でタンタルリードの代わりに同形状のニ - 10 オブリードを使用した以外は実施例1と同様にしてコン デンサを作製した。

#### 【() () 3 () 】参考例

比較例9でニオブ粉の代わりに同粒径のタンタル紛を使 用し、また誘電体を該タンタル粉から作製した焼結体を 化成することによって得た酸化タンタルとした以外は比 較例9と同様にしてコンデンサを作製した。以上、作製 したコンデンサの性能値を表2に示した。

[0031]

【表1】

	他方の電磁及が電導度 Scゅ・1	電優影成方法
突施例 1	テトラチオテトラセンの クロラニル結体 2×10°	左記化合物溶液中への 浸漬乾燥の繰り返し
2 س	テトラシアノキノジメタン のイソキノリン鎖体 3×10°	を記化合物容額中への 浸透乾燥の繰り返し
<i>n</i> 3.	ポリアニリンの トルエンスルホン酸ドーブ 3×10'	アニリン <del>液中での酸化反応</del> 最り返し
4 ب	ボリピロールの トルエンスルホン酸ドーブ 5×10!	ピロール液中での酸化反応 繰り返し
<i>#</i> 5	ポリチオフェンの トルエンスルホン酸ドープ 4×10′	チオフェン液中での酸化 反応減り返し
* 6	二酸化鉛と硫酸鉛の混合物 (二酸化鉛97w L%) 5×10′	酢酸熱溶酸での酸化反応 繰り返し
<i>"</i> 7	二酸化マンガンと二酸化鉛 (二酸化鉛85wt%) 5×10 <sup>:</sup>	領職マンガンの熱分解 (250 で、2回罪り返し)後、酢酸 気溶液での軽化反応繰り返し

(5)

特闘2000-68157

7		8
	# F 安 语	LC (2.5Y)
実態倒1	Ţ	0.06
<i>#</i> 2	6	0.05
# 3	7	0.07
<i>o</i> 4	7	0, 06
# 5	6	0.05
<b>∞</b> 6	7	0.06
<i>"</i> 7	7	0.08
8 ٪	4	0.04
<i>&gt;</i> 3	4 5	0.15
<b># 10</b>	5 0	0.10
比較例 I	7	2
2 بر	6	3
<b>"</b> 3	7	2
<i>u</i> 4	7	4
. E	τ	2
6 ب	. 7	3
» 7	7	2
<i>1</i> 8	4	0.9
<i>"</i> 9	4 5	10
* 1 ¢	5 O	8
参 考 例	J 8	9.01

# [0033]

【発明の効果】本発明による電極の一方をニオブ又はニ オブの一部を窒化した窒化ニオブとし、該電極に電気的 に付着した外部引出しリードをタンタルとしたコンデン がは、単位重量あたりの容量が大きく、LC特性が良好 である。特に該コンデンサの誘電体を酸化ニオブとした 40 1 ニオブ又は窒化ニオブ電極 コンデンサは、より容量が大きくLC特性等の性能が良

好なため、小型高容量なコンデンサとなりうる。

# 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のコンデンサの一方の電極を例示する模 式図。

## 【符号の説明】

- - 2 外部引出しリード

(5)

特闘2000-68157

[図1]

